Commence of the second



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60065712 A

(43) Date of publication of application: 15 , 04 , 85

(51) Int. CI

C01B 33/113 // B01J 19/12

(21) Application number: 68172222

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(22) Date of filing: 20 . 09 . 83

(72) inventor.

HAYAMA NORIYUKI YUGE YOU WATANABE TSUTOMU ISHIZAKI ARIYOSHI

(54) FORMATION OF SILICON OXIDE COATING FILM

(57) Abstract:

PURPOSE: A substrate is coated with an organosilicon compound containing ultra- violet absorbing substances and sintered in an oxidative atmosphere as ultraviolet rays are irradiated to effect oxidation whereby good costing films of silicon codde are formed at relatively low temperatures.

CONSTITUTION: A substrate to coated with an

organosilicon compound containing an ultraviolet absorbing substance such as an organotitanium compound and placed in a heating furnace, then baked in an oxidative atmosphere at about 350°C, as ultraviolet rays are irradiated to oxidize the organosilicon compound and form coating films of silicon code on the substrate. Thus, silicon oxide coating films used as optical interference films with high retractive index.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

母公開特許公報(A)

昭60-65712

@Int_Cl_4 C 01 B 33/113 # B 01 J 19/12

į

級別記号

广内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)4月15日

7059-4G 6542-4G

審査請求 未請求 発明の散 1 (全 3 頁)

❸発明の名称 酸化けい素被膜の形成方法

砂特 関 昭58-172222

參出 顧 昭58(1983)9月20日

₽ 明 老 Ш 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 伊発 明 者 弓 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 砂発 明 渖 辺 カ 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 賀工場内 034 明 横須賀市船越町1の201の1 東京芝浦電気株式会社横須 贺工場内

の出 顕 人 株 式 会 社 東 芝の代 瑾 人 弁理士 井上 一男

川崎市幸区堀川町72番地

49 **40**

1. 强明の名称

酸化けい素被膜の形成方法

2、作件資本の根因

(1) 無外額表収性物質を含む有級けい来化合物を 者体に独布し、そののも酸化性雰囲気中にから 素外部で無針しながら始成して上記有機に形成力 合物を酸化して酸化けい素がらなる被膜に形成力 ることを特徴とする酸化けい素を膜の形成方。 (3) 無外額級収性物質は有機金属化を物である とを特徴とする特許請求の範囲属1項記載の酸化 とを特徴とする特許請求の範囲属1項記載の放化

3. 発明の詳細を説明

〔発明の技術分野〕

けい素被膜の形成方法。

本発明は 敗化けい 素被膜の形成方法の改良に質する。

〔発明の技能的背景とその問題点〕

酸化けい素薄膜は安定で低層折率でしかも展昇 を任意に形成できるととにより、元学寡膜として 古くから利用されている。また、近年に載り、故 島セル用ガラス板のナトリウム市出防止駅とて多用されるようになった。このような硬化けい気被 鉄の形成方法として、従来、真空薫ガ法、スペッ メ 法、化学的気相析出法などが知られているが、 これらの方法はいずれも製造後優が複様で作意怪 にも離点があった。

との方法は袋屋が簡便で、作祭性が良く、大道 数の基体や複雑な形状の基体だも形成が容易であ る。しかし、その反面、強固で安定な威を持るためには、 7 0 0 で以上の高級で協成することが必要で、エネルギ的に問題があつた。

(発明の目的)

í

į

本現界は比較的低盛で発成できる機化けい素被 葉の形成方法を提供することを目的とする。

(発明の紙長)

有限けいま化合物に無外線吸収物質を終加して 基体に強和し、酸化性雰囲気中にかいて前外線を 無対したがら鈍成することにより、有機けい素化 合物に良く採外線を摂収させ、その元化学作用に よつて比較的低温で有機けい素化合物を硬化して 良好な硬化けい素被膜を形成するものである。 〔発明の実施例〕

(元のし天成的)

要化けいま薄膜と酸化チタン溶膜とを4層づつ 交互重層してなる光干浄質の形成を例にして説明 する。

310a 換算で10重量 # のけいまを含む有後けい 末化合物箱収に、Ti : 81 (原子比) = 3.5:100 の有機テタン化合物たとえばアルコセンドを動加 特別性 GU- G5712(2)

し、前一に混合した。との混合液に仮状ガラス塩 体を浸渍し、180四/分の速度で引上げて後布 した。ついて、100V定格高圧水鉄ランプ(本 を装備した紫外線炉に入れて空気が配気で提成を 行走つた。との伊は紫外線強度300mW/皿、森 度350℃が得られるものである。この低低化よ つて基体に患者した有法けい素化合物は単数では 2537mm以上の中放長かよび長放長の気外離をほ とんど数収しないにもかかわらず、有級テメン化 合物の共存によつて常外憩を良く吸収するように なり、その元化学作用によつて有機けいお化合物 かよび有機チョン化合物の両者とも350℃とい り比較的低温であるにもかかわらず、完全に疎化 されて小量の酸化チメンが臨入した酸化けい流か らたる群膜化形成された。ちたみに、この位化け い未存践の該厚は1300%で、風折率は1.50で

つぎに、との敗化けい来郷膜を形成した基体を TIO: 換算で 6 重量 5 の有級テタン 化合物 たとえば アルコキンドの前に浸漉し、 2 2 0 mm / 分の選収

で引上げ、上述の政化サい素率膜形成のときと同様な条件で美成し、限化チタン存取化形成した。 ちなみに、この政化チタン存成の次序は $150.0 \, {\rm \AA}$ で、 思折率は 2.1.5であつた。

そうして、以上の操作をそれぞれ4回交互には 返すことにより8層が重傷してなる光干部数が形 成された。

この九干参談は基体全面にわたり、所留の光学 特性を有し、ぞの特性分布も均一であつた。ちな みに、その光学特性を配に示す。別は挟動に改長 を Mm の単位でとり、契軸に光透過率かよび光反射 率をいずれるがの単位でとつたもので曲線仏(実 報で示す。)は透過率、曲線四(破機で示す。) は反射率をそれぞれ示す。

をお、約述の実施例に対し、比較のため、有扱けい常化合物に有扱チタン化合物を感加することを(用い、前述と同様にして光干沙臓を形成したところ、4~5層目で膜全体に利益が生じた。この選由は取化けい素等膜形成に頼し、有後けい素化合物の一部が充分に東化分解しないまま設督し、

しかして、常外級級权性物質の終加性は多いほど有機けい常化合物の酸化分解が良くなるが、たとえばテタンの場合化は得られた酸化けい素が貶の原折率を上昇させるので、光干多談として用いる場合には2000から抵加量が制度される。他の常外線吸収性物質にも抵加量を銀定する場合がある。

せた、常外族の収性物質として有級メンタル化

会物を使用できる。この場合、彼化タンタルは歴 化ナタンと比較して紫外線の吸収等が若干短波及 例へシフトしているが、それでも300m以下の 紫外線に吸収等があるので適当を技長級の紫外線 を用いればよい。また、酸化タンタルの風折率は 酸化チタンのそれより低く、酸化けい素線の 放化適当である。また、糖成条件にもよるが、可 現代透過率の向上も計り易い。そして得られた型 化けい素線の酸化タンタル混入率がTa:81(子比)で5:100の場合屈折率が1.50で10: 100の場合屈折率が1.53であつた。また、旋 の数層性も真好であつた。

また、被品セル用ガラス板のナトリウム溶出防止用酸化けい常被膜の形成の場合も前述と同様にして実施できる。そうして、酸化けい常被膜の膜 厚は従来技術と同様にして任意に形成できる。

また、本発明にかいて佐成雰囲気は空気に取らず、空気または窒素をどに放案。オゾンをどを通 宜添加して酸化飽を開致した気体でもよい。さら に、有扱けい象化合物の最布方法は任意である。 特期昭60-65712(3)

さらに、 遊体の材質、 単状、 大小あるいはその 用途については制限はない。

(発明の効果)

本発明の酸化被膜の形成方法は紫外部及収性物質を軽加した存機けい紫化合物を海体に成むし、酸化性界面気中にかいて紫外線限射しながら焼成して有機けい紫化合物を酸化し塩化けい紫からたる破膜に形成したので、紫外線の光化学作用によって比較的低温でも度好に有機けい紫化合物を放化分解することができ、健成エネルギ節約に役立っ

4. 図面の簡単を説明

図は本発明の取化けい米被説の形成方法の一実 施例を適用して得られた光干部説の一例の光学特 性を示すグラフである。

化组人 非典士 非 上 二 川

